MANUFACTURING METHOD OF LAMINATED ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND DISPLAY DEVICE

Patent number:

JP2005251529

Publication date:

2005-09-15

Inventor:

ISHIDA KOUHEI

Applicant:

SEIKO EPSON CORP

Classification:

- international:

H05B33/10; B05D1/26; B05D5/06; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/22; H05B33/10; B05D1/26; B05D5/06; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): H05B33/10; B05D1/26; B05D5/06; H05B33/12; H05B33/14;

H05B33/22

- european:

Application number: JP20040059307 20040303 Priority number(s): JP20040059307 20040303

Also published as:

US2005196526 (A CN1665357 (A)

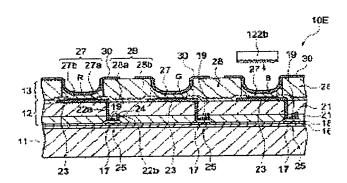
Report a data error he

Abstract of JP2005251529

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a manufacturing method with a high production rate of an organic El element made by each light-emitting layer being separated by a charge generation layer at least made of one layer in a laminated organic EL element having at least one layer of light-emitting unit between an anode and a cathode facing each other.

SOLUTION: In the manufacturing method of a laminated organic electroluminescent element including at least one light-emitting layer between a transparent anode and a cathode facing each other and a plurality of light-emitting units separated by charge generation layers made of at least one layer, at least one of the charge generation layers is formed using a discharge device, and a display device is equipped with the laminated type organic EL elements obtained by this manufacturing method.

COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

JP 2005-251529 A 2005.9.15 (11)特許出願公開番号

特開2005-251529

(P2005-251529A)

(43)公開日 平成17年9月15日(2005.9.15)

(51) Int. Cl. 7	F I			テーマコード(参考)			
H 0 5 B	33/10	H 0 5 B	33/10		_	K007	
B 0 5 D		2002	1/26	Z	4	D 0 7 5	
B 0 5 D	5/06	B 0 5 D	5/06	В			
H05B	33/12	H 0 5 B	33/12	В			
н05В		H 0 5 B		Α			
		審査	請求有	請求項の数13	OL	(全20頁)	最終頁に続く

(21)出願番号

特願2004-59307(P2004-59307)

(22)出願日

平成16年3月3日(2004.3.3)

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(74)代理人 100095728

弁理士 上柳 雅誉

(74)代理人 100107076

弁理士 藤綱 英吉

(74)代理人 100107261

弁理士 須澤 修

(72)発明者 石田 絋平

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB18 BA05 BA06 DA01

DA06 DB03 FA01

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法及び表示装置

(57)【要約】

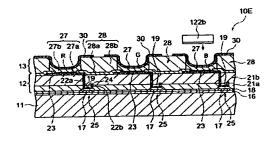
【課題】

対向する陽極電極と陰極電極との間に少なくとも一層 の発光ユニットを有する積層型有機EL素子において、 各発光層が少なくとも一層からなる電荷発生層によって 仕切られてなる有機EL素子を、高い生産効率で製造す る方法を提供する。

【解決手段】

対向する透明陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも 一層の発光層を含み、かつ、少なくとも一層からなる電 荷発生層によって仕切られた発光ユニットを複数個有す る積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 であって、前記電荷発生層の少なくとも一つを吐出装置 を用いて形成することを特徴とする積層型有機エレクト ロルミネッセンス素子の製造方法、及びこの製造方法に より得られる積層型有機EL素子を備える表示装置。

【選択図】 図11



【特許請求の範囲】

【請求項1】

対向する透明陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも一層の発光層を含み、かつ、少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切られた発光ユニットを複数個有する積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、前記電荷発生層の少なくとも一つを吐出装置を用いて形成することを特徴とする積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項2】

1. 0×10°Ω・cm以上の比抵抗を有する電気絶縁層である電荷発生層を形成することを特徴とする請求項1に記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 10

【請求項3】

可視光の透過率が50%以上の層である電荷発生層を形成することを特徴とする請求項1または2に記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項4】

異なる2種類の物質の積層体又は混合層からなり、該2種類の物質間で酸化還元反応によるラジカルカチオンとラジカルアニオンからなる電荷移動錯体が形成してなる電荷発生層を形成することを特徴とする請求項1~3のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項5】

(a) イオン化ポテンシャルが5. 7 e Vより小さく、電子供与性を有する有機化合物と、(b) 前記(a) の有機化合物と酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しうる無機物質及び/若しくは有機物質とからなる積層体又は混合層からなり、前記(a) 成分と(b) 成分との間で酸化還元反応による電荷移動錯体が形成してなる電荷発生層を形成することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項6】

前記 (a) 成分として、一般式 (I):

【化1】

 Ar_{2} $Ar_{1} - N - Ar_{3}$

(式中、Arı、Ar₂及びAr。は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水素基を表す。)で示されるアリールアミン化合物を用いることを特徴とする請求項 5 に記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項7】

前記 (b) 成分の無機物質として、金属酸化物を用いることを特徴とする請求項 5 また 40 は 6 に記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項8】

前記(b)成分の無機物質として、金属ハロゲン化物を用いることを特徴とする請求項5~7のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項9】

前記(b)成分の有機物質として、少なくとも1個のフッ素を置換基として有し、電子 受容性を有する有機化合物を用いることを特徴とする請求項5~8のいずれかに記載の積 層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項10】

前記(b)成分の有機物質として、少なくとも1個のシアノ基を置換基として有し、電 50

20

子受容性を有する有機化合物を用いることを特徴とする請求項 5 ~ 9 のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項11】

前記発光ユニットを吐出装置を用いて形成することを特徴とする請求項1~10のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項12】

前記発光ユニットが正孔注入/輸送層と発光層とからなり、該正孔注入/輸送層および/または発光層を吐出装置を用いて形成することを特徴とする請求項1~11のいずれかに記載の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

【請求項13】

10

30

請求項1~12のいずれかに記載の製造方法により得られる積層型有機エレクトロルミネッセンス素子を備えることを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、平面光源や表示素子に利用される有機エレクトロルミネッセンス素子(以下、「有機EL素子」という)の製造方法に関する。さらに詳しくは、対向する透明陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも一層の発光層を含み、かつ、少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切られた発光ユニットを複数個有する積層型有機EL素子を効率よく製造する方法、及びこの製造方法により得られた積層型有機EL素子を備える表示装置に 20 関する。

【背景技術】

[0002]

対向する陽極電極と陰極電極との間に、有機化合物からなる発光層を有する有機EL素子は、近年、低電圧駆動の大面積表示素子を実現するものとして注目されている(例えば、非特許文献1)。しかしながら、従来の有機EL素子は、素子寿命の観点では、ディスプレイ表示装置用途で必要とされる約100cd/m²程度の輝度でようやく1万時間を超える半減寿命が達成されるに至ったにすぎず、照明用途等で必要とされる約1000cd/m²~約1000cd/m²程度の輝度で実用上必要な素子寿命を得ることは、現段階では依然として難しいとされている。

[0003]

かかる問題を解決すべく、特許文献1には、対向する陽極電極と陰極電極との間に複数個の発光ユニットを有し、各発光ユニットがそれぞれ1層の等電位面を形成する層が可視光の透過率50%以上の透明電極材料からなる有機EL素子が提案されている。

しかしながら、導電率の高い(比抵抗の高い)物質を使用して複数の発光ユニットを仕切った場合、面方向(基板に平行な方向)への導電性によって発光エリアが思い通りに規定することが困難な場合があった。また、この文献に記載された方法は生産性に劣るものであった。

[0004]

特許文献 2 には、対向する陽極電極と陰極電極との間に少なくとも一層の発光ユニット 40 を有する有機 E L 素子において、各発光層が少なくとも一層からなる電荷発生層によって 仕切られており、該電荷発生層が 1 . 0 × 1 0 ² Ω · c m以上の比抵抗を有する電気的絶縁層であることを特徴とする有機 E L 素子が提案されている。この文献に記載された有機 E L 素子によれば、両電極間に所定電圧が印加されたとき、陰極と陽極が交差する領域に存在する複数の発光ユニットのみが(あたかも直列的に接続されたかのように)同時に発光して、従来型の有機 E L 素子では実現不可能であった高い量子効率(又は電流効率)を実現することができる。

[0005]

しかしながら、この文献記載の有機EL素子の電荷発生層は、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、レーザービーム蒸着法、スパッタリング法等を用いる方法で形成しており、 50

、生産性が低いという問題があった。

したがって、電荷発生層を構成する有機材料を無駄にせず、簡便にかつ微細にパターニ ングして成膜する手段の開発が要求されていた。

【非特許文献1】"有機ELのすべて"城戸淳二著、日本実業出版社(2003年2月2 08)

【特許文献1】特開2003-45676号公報

[特許文献2] 特開2003-272860号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0006]

本発明はかかる従来技術の実情に鑑みてなされたものであり、前記特許文献 2 に記載さ れるがごとく、対向する陽極電極と陰極電極との間に少なくとも一層の発光ユニットを有 する積層型有機EL素子において、各発光層が少なくとも一層からなる電荷発生層によっ て仕切られてなる有機EL素子を、高い生産効率で製造する方法を提供することを課題と する。

【課題を解決するための手段】

[0007]

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究した結果、対向する陽極電極と陰極電極 との間に少なくとも一層の発光ユニットを有する積層型有機EL素子において、各発光層 が少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切られてなる積層型有機EL素子を製造 20 するに際し、電荷発生層を吐出装置を用いて形成すると、優れた性能を有する積層型有機 EL素子を、高い生産効率で製造することができることを見出し、本発明を完成するに至 った。

[0008]

かくして本発明の第1によれば、下記の(1)~(12)の積層型有機エレクトロルミ ネッセンス素子の製造方法が提供される。

(1)対向する透明陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも一層の発光層を含み、かつ、 少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切られた発光ユニットを複数個有する積層 型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法であって、前記電荷発生層の少なくとも 一つを吐出装置を用いて形成することを特徴とする積層型有機エレクトロルミネッセンス 30 素子の製造方法。

(2) 1. 0×10°Ω・cm以上の比抵抗を有する電気絶縁層である電荷発生層を形成 することを特徴とする(1)の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

[0009]

- (3) 可視光の透過率が50%以上の層である電荷発生層を形成することを特徴とする(1) 又は(2) の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。
- (4) 異なる2種類の物質の積層体又は混合層からなり、該2種類の物質間で酸化還元反 応によるラジカルカチオンとラジカルアニオンからなる電荷移動錯体が形成してなる電荷 発生層を形成することを特徴とする(1)~(3)いずれかの積層型有機エレクトロルミ ネッセンス素子の製造方法。

[0010]

(5) (a) イオン化ポテンシャルが 5.7 e V より小さく、ホール輸送性すなわち電子 供与性を有する有機化合物と、 (b) 前記 (a) の有機化合物と酸化還元反応による電荷 移動錯体を形成しうる無機物質又は有機物質とからなる積層体又は混合層からなり、前記 (a) 成分と (b) 成分との間で酸化還元反応による電荷移動錯体が形成しているもので ある電荷発生層を形成することを特徴とする(1)~(4)いずれかの積層型有機エレク トロルミネッセンス素子の製造方法。

(6) 前記(a) 成分として、一般式(I)

[0011]

10

[化1]

$$Ar_{1} \xrightarrow{Ar_{2}} Ar_{1} \xrightarrow{(I)}$$

[0012]

(式中、Ar,、Ar。及びAr。は、それぞれ独立に置換基を有してよい芳香族炭化水 素基を表す。)で示されるアリールアミン化合物を用いることを特徴とする(5)の積層 10 型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

(7) 前記 (b) 成分の無機物質として、金属酸化物を用いることを特徴とする (5) ま たは(6)の積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

[0013]

(8) 前記 (b) 成分の無機物質として、金属ハロゲン化物を用いることを特徴とする (5)~(7)いずれかの積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

(9)前記(b)成分の有機物質として、少なくとも1個のフッ素を置換基として有し、 電子受容性を有する有機化合物を用いることを特徴とする(5) ~ (8) いずれかの積層 型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

[0014]

(10)前記(b)成分の有機物質として、少なくとも1個のシアノ基を置換基として有 し、電子受容性を有する有機化合物を用いることを特徴とする(5) ~ (9) いずれかの 積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

(11)前記発光ユニットを吐出装置を用いて形成することを特徴とする(1)~(10) いずれかの積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

(12)前記発光ユニットが正孔注入/輸送層と発光層とからなり、該正孔注入/輸送層 および/または発光層を吐出装置を用いて形成することを特徴とする(1)~(11)い ずれかの積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法。

[0015]

本発明によれば、対向する陽極電極と陰極電極との間に少なくとも一層の発光ユニット 30 を有する積層型有機EL素子において、各発光層が少なくとも一層からなる電荷発生層に よって仕切られてなる、高品質の積層型有機EL素子を、高い生産効率で製造することが できる。

[0016]

本発明の第2によれば、本発明の製造方法により得られる積層型有機エレクトロルミネ ッセンス素子を備えることを特徴とする表示装置が提供される。

本発明の表示装置は、高い生産効率で得られる高品質の積層型有機EL素子を備えるの で、低価格で耐久性に優れ、低電力、かつ画像表示に優れる表示装置である。

【発明を実施するための最良の形態】

[0017]

以下、本発明の積層型有機EL素子の製造方法及び表示装置について詳細に説明する。

1) 積層型有機 E L 素子の製造方法

本発明の積層型有機EL素子の製造方法は、対向する透明陽極電極と陰極電極の間に、 少なくとも一層の発光層を含み、かつ、少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切 られた発光ユニットを複数個有する積層型有機エレクトロルミネッセンス素子の製造方法 であって、前記電荷発生層の少なくとも一つを吐出装置を用いて形成することを特徴とす る。

[0018]

本発明において、「発光ユニット」とは、少なくとも一層の発光層を含む層構造を有し 、従来型有機EL素子の構成要素のうち陽極電極と陰極電極を除いた構成要素を指す。前 50

20

記「発光ユニット」としては、例えば、(陽極電極)/発光層/(陰極電極)、(陽極電極)/正孔注入/輸送層/発光層/(陰極電極)等の走行性を有するものが挙げられる。 【0019】

また、「電荷発生層」とは、電圧印加時において素子の陰極方向にホールを注入し、陽極方向に電子を注入する役割を果たす層のことをいい、好ましくは $1.0\times10^2~\Omega\cdot c$ m以上、より好ましくは $1.0\times10^5~\Omega\cdot c$ m以上の比抵抗を有する電気絶縁性の層である。

[0020]

図1に、本発明の製造方法により製造される積層型有機EL素子の一例の構造断面図を示す。図1に示す積層型有機EL素子は、陽極電極2と陰極電極5の間に、 n 個の発光ユ 10 ニット(3-1~3-n)が、電荷発生層(4-1~4-(n -1))で仕切られて形成されている。すなわち、ガラス基板(透明基板)1の上に、 頗に、 陽極電を構成する透明陽極電極2、発光ユニット3-1、電荷発生層4-1、発光ユニット3-2、電荷発生層4-2、・・・、電荷発生層4-(n -1)、発光ユニット3-2が繰り返され、最低に陰極電極5が積層されている。これらのうち、ガラス基板(透明基板)1、透明陽極電を2、発光ユニット(3-n)(ただし、 n は自然数を表す。以下にて同じ))、 陰極電極5は周知の要素であり、電荷発生層(4-n)によって仕切られた複数の発光ユニット(3-n)が両電極間に存在する点が従来の有機EL素子と異なる。

[0021]

以下、本発明の積層型有機EL素子の製造方法を、図1に示す積層型有機EL素子うち 20、図2に概略図として示す2層積層型の有機EL素子を例にとって、詳細に説明する。

[0022]

図2に示す積層型有機EL素子は、下側から、透明基板1、陽極電極2、発光ユニット3-1、電荷発生層4-1、発光ユニット3-2、陰極電極5から構成されている。また、発光ユニット3-1及び3-2はともに、正孔注入/輸送層3aと発光層3bの2層構造を有している。本実施形態では、上記層構成のうち、発光ユニット3-1、電荷発生層4-1、及び発光ユニット3-2を吐出装置を使用して形成するものである。

[0023]

本実施形態に用いる吐出装置は、吐出物を吐出ヘッドによりインクジェット方式によって吐出するものであればよい。例えば、加熱発泡により気泡を発生し、液滴の吐出を行う 30 サーマル方式の吐出手段、ピエゾ素子を利用する圧縮により、液滴の吐出を行なうピエゾ方式の吐出装置等が挙げられる。

[0024]

本実施形態に用いる吐出装置の一例を図3に示す。図3は、この発明の実施の形態に係る燃料電池を製造する際に用いられるインクジェット式の吐出装置120aの構成の概略を示す図である。この吐出装置120aは、基板上に吐出物を吐出するインクジェットへッド122は、ヘッド本体124及び吐出物を吐出する多数のノズルが形成されているノズル形成面126を備えている。このノズル形成面126を備えている。このノズル形成面126のノズルから吐出物、即ち、正孔注入/輸送層形成材料が吐出される。

[0025]

また、吐出装置120aは、基板を載置するテーブル128を備えている。このテーブル128は、所定の方向、例えば、X軸方向、Y軸方向及び Z 軸方向に移動可能に設置されている。また、テーブル128は、図中矢印で示すように X 軸に沿った方向に移動することにより、図示を省略するベルトコンベアにより搬送される処理基板をテーブル128上に載置して、吐出装置120a内に取り込む。

[0026]

また、インクジェットヘッド122には、ノズル形成面126に形成されているノズルから吐出される吐出物である、正孔注入/輸送層形成材料を収容しているタンク130が接続されている。即ち、タンク130とインクジェットヘッド122とは、吐出物を搬送する吐出物搬送管132によって接続されている。

[0027]

この吐出物搬送管 1 3 2 は、吐出物搬送管 1 3 2 の流路内の帯電を防止するための吐出物流路部アース継手 1 3 2 a とヘッド部気泡排除弁 1 3 2 b とを備えている。このヘッド部気泡排除弁 1 3 2 b は、後述する吸引キャップ 1 4 0 により、インクジェットヘッド 1 2 2 内の吐出物を吸引する場合に用いられる。即ち、吸引キャップ 1 4 0 によりインクジェットヘッド 1 2 2 内の吐出物を吸引するときは、このヘッド部気泡排除弁 1 3 2 b を閉状態にし、タンク 1 3 0 側から吐出物が流入しない状態にする。そして、吸引キャップ 1 4 0 で吸引すると、吸引される吐出物の流速が上がり、インクジェットヘッド 1 2 2 内の気泡が速やかに排出されることになる。

[0028]

また、吐出装置120aは、タンク130内に収容されている吐出物の収容量、即ち、タンク130内に収容されている吐出物の液面134aの高さを制御するための液面制御センサ136を備えている。この液面制御センサ136は、インクジェットヘッド122が備えるノズル形成面126の先端部126aとタンク130内の液面134aとの高さを制御することで、タンク130内の吐出物134が所定の範囲内の圧力でインクジェットヘッド122に送られることになる。そして、所定の範囲内の圧力で吐出物134を送ることで、インクジェットヘッド22から安定的に吐出物134を吐出することができる。

[0029]

インクジェットヘッド122のノズル形成面126に対向して一定の距離を隔てて、イ 20ンクジェットヘッド122のノズル内の吐出物を吸引する吸引キャップ140が配置されている。

[0030]

この吸引キャップ140は、図3中に矢印で示す2軸に沿った方向に移動可能に構成されており、ノズル形成面126に形成された複数のノズルを囲むようにノズル形成面126に密着し、ノズル形成面126との間に密閉空間を形成してノズルを外気から遮断できる構成となっている。

[0031]

吸引キャップ140によるインクジェットヘッド122のノズル内の吐出物の吸引は、インクジェットヘッド122が吐出物134を吐出をしていない状態、例えば、インクジ 30ェットヘッド122が、退避位置等に退避しており、テーブル128が破線で示す位置に退避しているときに行われる。

[0032]

また、この吸引キャップ140の下方には、流路が設けられており、この流路には、吸引バルブ142、吸引異常を検出する吸引圧検出センサ144及びチューブポンプ等からなる吸引ポンプ146が配置されている。また、この吸引ポンプ146等で吸引され、流路を搬送されてきた吐出物134は、廃液タンク148内に収容される。

[0033]

なお、本実施形態においては、吐出装置として、正孔注入/輸送層形成材料を吐出する吐出装置、発光層形成材料を吐出する吐出装置、及び電荷発生層形成材料を吐出する吐出 40 装置を用いるが、これらの吐出装置は、吐出物が異なる点を除けば、図3に示す吐出装置120aと同様の構成のものである。

[0034]

次に、図4に示す工程図及び図面を参照して、図2に示す2層積層型有機EL素子の製造方法を詳細に説明する。

図2に示す2層積層型有機EL素子は、図4に示すように、パンク部形成工程(S2)、表面処理工程(S3)、正孔注入/輸送層(I)形成工程(S4)、発光層(I)形成工程(S5)、電荷発生層形成工程(S6)、正孔注入/輸送層(II)形成工程(S7)、発光層(II)形成工程(S8)、陰極電極形成工程(S9)を経て製造される。なお、製造工程は例示するものに限られるものではなく必要に応じてその他の工程が除かれ 50

る場合、また追加される場合もある。

[0035]

スタート (S1)

まず、バンク部形成工程(S2)に供する基板10Aを用意する。

基板10Aの構造断面図を図5に示す。図5中、11は透明基板、12は回路素子部で ある。回路素子部12と基板11との間には、シリコン酸化膜からなる下地保護膜16が 形成され、この下地保護膜16上に多結晶シリコンからなる島状の半導体膜17が形成さ れている。この半導体膜17の左右の領域には、ソース領域及びドレイン領域が高濃度陽 イオン打ち込みによりそれぞれ形成されている。そして陽イオンが打ち込まれない中央部 がチャネル領域となっている。なお、図5においては、ソース領域、ドレイン領域及びチ 10 ャネル領域の区別を省略している(以下にて同じである)。

[0036]

回路素子部12には、下地保護膜16及び半導体膜17を被う透明なゲート絶縁膜18 が形成され、このゲート絶縁膜18上の半導体膜17のチャネル領域に対応する位置には 、例えばA1、Mo、Ta、Ti、W等から構成されるゲート電極19が形成されている 。このゲート電極19及びゲート絶縁膜18上には、透明な第1層間絶縁膜21aと第2 層間絶縁膜21bが形成されている。また、第1、第2層間絶縁膜21a、21bを貫通 して、半導体膜17のソース領域、ドレイン領域にそれぞれ連通するコンタクトホール2 2 a, 2 2 b が形成されている。

[0037]

そして、第2層間絶縁膜21b上には、ITO等からなる透明な陽極電極23が所定の 形状にパターニングされて形成され、この陽極電極23は、コンタクトホール22aを通 じてソース領域に接続されている。

[0038]

陽極電極材料としては、特に制限はなく、例えば、ITO(インジウム・すず酸化物) 、IZ〇(インジウム・亜鉛酸化物)等の透明導電材料を使用することができる。

[0039]

また、第1層間絶縁膜21a上には図示しない電源線が配設されており、この電源線2 4は、コンタクトホール22bを通じてドレイン領域に接続されている。

このように、回路素子部12には、各陽極電極23に接続された駆動用の薄膜トランジ 30 スタ25がそれぞれ形成されている。

[0 0 4 0]

バンク部形成工程(S2)

次に、図5に示した基板10Aを、バンク部形成工程(S2)に供する。この工程では 、まず、第2層間絶縁膜21b上に無機物バンク層28aを形成する。この無機物バンク 層28aは、形成位置に無機物膜を形成した後、この無機物膜をフォトリソグラフィ技術 等によりパターニングすることにより形成される。このとき、無機物バンク層28aの一 部は陽極電極23の周縁部と重なるように形成される。

[0041]

次いで、無機物バンク層28a上に有機物バンク層28bを形成する。この有機物バン 40 ク層28bも、無機物パンク層28aと同様にフォトリソグラフィ技術等によりパターニ ングして形成される。このようにして、無機物パンク層28aと有機物バンク層28bと からなるバンク部28が形成される。また、これに伴い、各バンク部28間には、陽極電 極23に対して上方に開口した開口部29が形成される。この開口部29は、画素領域を 規定する。

[0042]

表面処理工程(S3)

次の表面処理工程(S3)では、親液化処理及び撥液化処理が行われる。親液化処理を 施す領域は、無機物バンク層28aの第1積層部及び陽極電極23の電極面である。これ らの領域は、例えば酸素を処理ガスとするプラズマ処理によって親液性に表面処理される 50

20

30

40

。このプラズマ処理は、陽極電極23であるITOの洗浄等も兼ねている。また、親液化処理は、有機物バンク層28bの壁面部及び有機物バンク層28bの上面部にも施される。例えば、4フッ化メタンを処理ガスとするプラズマ処理によって表面がフッ化処理(撥水性に処理)される。

[0043]

この表面処理工程を行うことにより、後工程において、吐出装置を用いて機能層27を 形成する際に、機能液滴を画素領域により確実に着弾させることができ、また、画素領域 に着弾した機能液滴が開口部29から溢れ出るのを防止することが可能となる。

[0044]

以上の工程を経ることにより、図6に示す表示装置基体10Bが得られる。

この表示装置基体 1 0 B は、図 3 に示した(又はこれと同様の)液滴吐出装置のセットテーブル 1 2 8 に載置され、以下の正孔注入/輸送層(I)形成工程(S 4)、発光層(I)形成工程(S 5)及び電荷発生層形成工程(S 6)が行われる。

[0045]

正孔注入/輸送層(I)形成工程(S4)

正孔注入/輸送層形成工程(S4)では、図3に示す液滴吐出ヘッド122から正孔注入/輸送層形成材料を含む第1組成物を画素領域である各開口部29内に吐出する。その後、乾燥処理及び熱処理を行い、第1組成物に含まれる極性溶媒を蒸発させ、陽極電極(電極面23a)23上に正孔注入/輸送層27aを形成する。

以上のようにして、図7に示す基板10℃を得る。

[0046]

発光層形成工程 (S 5)

次に、発光層形成工程(S5)について説明する。

発光層は、図3に示すものと同様の吐出装置を用いて、発光層形成に用いる第2組成物を吐出して形成することができる。

[0047]

発光層形成工程では、上述したように、正孔注入/輸送層27aの再溶解を防止するために、発光層形成の際に用いる第2組成物の溶媒として、正孔注入/輸送層27aに対して不溶な非極性溶媒を用いるのが好ましい。

[0048]

またその一方で、正孔注入/輸送層27aは、非極性溶媒に対する親和性が低いため、非極性溶媒を含む第2組成物を正孔注入/輸送層27a上に吐出しても、正孔注入/輸送層27aと発光層27bとを密着させることができなくなるか、あるいは発光層27bを均一に塗布できないおそれがある。

[0049]

そこで、非極性溶媒ならびに発光層形成材料に対する正孔注入/輸送層 2 7 a の表面の 親和性を高めるために、発光層形成の前に表面処理(表面改質処理)を行うことが好まし い。この表面処理は、発光層形成の際に用いる第 2 組成物の非極性溶媒と同一溶媒または これに類する溶媒である表面改質材を、正孔注入/輸送層 2 7 a 上に塗布し、これを乾燥 させることにより行う。

[0050]

このような処理を施すことで、正孔注入/輸送層27aの表面が非極性溶媒になじみやすくなり、その後の工程で、発光層形成材料を含む第2組成物を正孔注入/輸送層27aに均一に塗布することができる。

[0051]

すなわち、図8に示すように、各色のうちの何れか(図8の例では青色(B))に対応する発光層形成材料を含有する第2組成物(B')を、機能液滴として画素領域(開口部29)内に吐出ヘッド122aから打ち込む。画素領域内に打ち込まれた第2組成物(B')は、正孔注入/輸送層27aに広がって開口部29内に満たされる。なお、万一、第2組成物が画素領域から外れてバンク部28の上面に着弾した場合でも、この上面は、上 50

述したように撥液処理が施されているので、第2組成物が開口部29内に転がり込み易く なっている。

[0052]

その後、乾燥工程等を行うことにより、吐出後の第2組成物を乾燥処理し、第2組成物 に含まれる非極性溶媒を蒸発させ、図9に示すように、正孔注入/輸送層27a上に発光 層 2 7 b が形成される。図 9 の場合、 青色 (B) に対応する発光層 2 7 b が形成されてい る。

[0053]

次いで、図8に示すのと同様の機能液滴吐出ヘッドを用い、上記した青色(B)に対応 する発光層27bの場合と同様の工程を順次行い、他の色(赤色(R)及び緑色(G)) 10 に対応する発光層27bを形成する。

[0054]

なお、発光層27bの形成順序は、例示した順序に限られるものではなく、どのような 順序で形成してもよい。例えば、発光層形成材料に応じて形成する順番を決める事も可能 である。また、赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)の3色の配列パターンとしては、 ストライプ配列、モザイク配列及びデルタ配列等がある。

[0055]

発光層 2 7 b は、赤色 (R)、緑色 (G) 又は青色 (B) の何れかに発光するもので、 発光層形成材料(発光材料)を含む第2組成物(機能液)を吐出することで形成される。 第2組成物の溶媒(非極性溶媒)としては、正孔注入/輸送層27aに対して不溶な公知 20 の材料を用いることが好ましく、このような非極性溶媒を発光層27bの第2組成物に用 いることにより、正孔注入/輸送層27aを再溶解させることなく発光層27bを形成す ることができる。そして、発光層27bでは、正孔注入/輸送層27aから注入された正 孔と、陰極電極から注入される電子が発光層で再結合して発光するように構成されている

[0056]

発光層形成材料としては、例えば、シアノポリフェニレンピニレン前駆体、色の有機発 光材料として、2-13',4'-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキ シー1-ベンゾビリリウムパークロレートと、1,1-ビス-(4-N,N-ジトリルア ミノフェニル)シクロヘキサンとの混合物などの赤色発光材料;

ポリフェニレンピニレン前駆体、2,3,6,7-テトラヒドロ-11-オキソー1H 5 H, 1 1 H - (1) ベンゾピラノ [6, 7, 8 - i j] - キノリジン- 1 0 - カルボ ン酸と、 1 , 1 - ピス - (4 - N , N - ジトリルアミノフェニル)シクロヘキサンとの混 合物などの緑色発光材料;

アルミニウムキノリノール錯体、トリス (8-ヒドロキシキノリノール) アルミニウム と、2,3,6,7-テトラヒドロー9-メチルー11-オキソー1H,5H,11H-(1) ペンゾピラノ [6, 7, 8 - i j] - キノリジンとの混合物などの青色発光材料; 等が挙げられる。

[0057]

また、その他として、アロマティックジアミン誘導体(TPD)、オキシジアゾール誘 40 導体 (PBD)、オキシジアゾールダイマー (OXD-8)、ジスチルアリーレン誘導体 (DSA)、ペリリウム-ベンゾキノリノール錯体 (Beba)、トリフェニルアミン誘 導体 (MTDATA)、ルブレン、キナクリドン、トリアソール誘導体、ポリフェニレン 、ポリアルキルフルオレン、ポリアルキルチオフェン、アゾメチン亜鉛錯体、ポリフィリ ン亜鉛錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、フェナントロリンユウロピウム錯体が使用で きるが、これに限られるものではない。

[0058]

より具体的には、特開昭63-70257号公報、特開昭63-175860号公報、 特開平2-135361号公報、特開平2-135359号公報、特開平3-15218 4号公報に記載されているもの等、公知のものが使用可能である。これらの化合物は単独 50

40

で用いてもよいし、2種類以上を混合して用いてもよい。

[0059]

以上のようにして、図10に示すように、陽極電極23上に機能層27、即ち、正孔注入/輸送層27a及び発光層27bが形成された基板10Dを得る。

[0060]

電荷発生層(I)形成工程(S 6)

次に、電荷発生層(Ⅰ)形成工程(S6)に移行する。

電荷発生層は、図11に示す液滴吐出ヘッド122bから、電荷発生層形成材料を含む 組成物を発光層27b及びバンク部28上の所定位置に吐出し、その後、乾燥処理及び熱 処理を行うことで形成することができる。

[0061]

本実施形態で形成する電荷発生層は、好ましくは1.0×10°Ω・cm以上、より好ましくは1.0×10°Ω・cm以上の比抵抗を有する電気絶縁性の層である。また、本実施形態で形成する電荷発生層は、可視光の透過率が50%以上の層であるのが好ましい。可視光の透過率が50%未満であると、生成した光が電荷発生層を通過する際に吸収され、複数の発光ユニットを有していても所望の量子効率(電流効率)が得られなくなるおそれがあるからである。

[0062]

用いる電荷発生層形成材料としては、電圧印加時において素子の陰極方向にホールを注入し、陽極方向に電子を注入する役割を果たす層を形成できるものであれば、特に制限されない。電荷発生層を形成する材料としては、無機物質でも有機物質でも使用可能であるが、異なる2種類の物質の積層体又は混合層からなり、この2種類の物質間で酸化還元反応によるラジカルカチオンとラジカルアニオンからなる電荷移動錯体が形成しており、該電荷移動錯体中のラジカルカチオン状態とラジカルアニオン状態が、電圧印加時にそれぞれ陰極方向と陽極方向へ移動することにより、前記電荷発生層の陰極側に接する発光ユニットへ電子を注入するものであるのが好ましい。

[0063]

電荷発生層形成材料として用いることができる有機化合物としては、前記一般式 (I)で示されるアリールアミン化合物、少なくとも1個のフッ素を置換基として有し、電子受 30 容性を有する有機化合物が挙げられる。

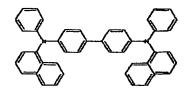
[0064]

前記アリールアミン化合物としては、特に限定はないが、例えば、特開平6-25659号公報、特開平6-215874号公報、特開平7-14516号公報、特開平7-257473号公報、特開平8-48656号公報、特開平7-126226号公報、特開平7-188130号公報、特開平8-40995号公報、特開平8-40996号公報、特開平8-40997号公報、特開平7-126225号公報、特開平7-101911号公報、特開平7-97355号公報に開示されているアリールアミン化合物類が挙げられる。

[0065]

4 - ジ- p - トリアミノフェニル) - 4 - フェニルシクロヘキサン、ピス (4 - ジメチル アミノ-2-メチルフェニル) -フェニルメタン、N, N, N-トリ (p-トリル) アミ ン、4-(ジ-p-トリルアミノ) -4'-[4(ジ-p-トリルアミノ) スチリル] ス チルベン、N, N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ-ピフェニルN-フェニルカルバゾール、 4 , 4 ' - ピス [N - (1 - ナフチル) - N - フェニルーアミノ] ピフェニル、4、4、' ーピス [Nー(1ーナフチル) ーNーフェニルーアミノ] pー ターフェニル、4, 4'ーピス [N-(3-rt)]フェニル)[N-rt]ピフェニル、1,5-ピス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルーアミノ]ナフタレン 、4,4'-ビス[N-(9-アントリル)-N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, , 4'-ビス [N-(2-フェナントリル)-N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, 4'-ビス[N-(8-フルオランテニル)-N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, 4'-ビス [N-(2-ピレニル)-N-フェニル-アミノ] ビフェニル、4, 4'-ビ ス [N-(2-ペリレニル)-N-フェニル-アミノ] ピフェニル、4,4'-ピス <math>[N(1-コロネニル) - N - フェニルーアミノ] ピフェニル、2,6-ビス(ジーp-ト リルアミノ) ナフタレン、2, 6-ビス[ジー(1-ナフチル) アミノ] ナフタレン、2 6 - ピス [N - (1 - ナフチル) - N - (2 - ナフチル) アミノ] ナフタレン、4. 4 '' - ピス [N , N - ジ (2 - ナフチル) アミノ] ターフェニル 、4 . 4 ' - ピス { N -フェニル-N- [4-(1-ナフチル)フェニル] アミノトピフェニル、4,4'-ピス [N-7+2N-N-(2-2V-2V)-7+2] [N-7+2V, 2, 6-2] [N, N-20]ジ (2-ナフチル) アミノ] フルオレン、4, 4' '-ビス (N, N-ジ-p-トリルア ミノ) ターフェニル、ピス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミン、下記の式

[0066] [化2]

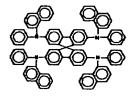


[0067]

で表される 4 , 4 ' - ピス [N - (2 - ナフチル) - N - フェニル - アミノ] ピフェニル (α - N P D)、下記の式:

[0068]

[化3]



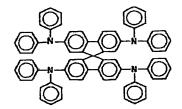
40

[0069]

で表されるスピローNPB、下記の式:

[0070]

[化4]

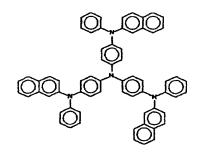


[0071]

で表されるスピロ-TAD、下記の式:

[0072]

【化5】



20

40

10

[0073]

で表される2-TNATA等が挙げられる。

なお、これらのアリールアミン化合物はガラス転移点が90℃以上であるものが、素子 の耐熱性の観点から望ましい。

本発明においては、その他、従来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適 宜用いることができる。

[0074]

また、少なくとも1個のフッ素を置換基として有し、電子受容性を有する有機化合物と 30 しては、DDQ(ジシアノ-ジクロロキノン)、TNF(トリニトロフルオレン)、TC NQ (テトラシアノキノジメタン)、4F-TCNQ等が挙げられる。

[0075]

前記電荷発生層形成材料として用いることができる無機化合物としては、酸化パナジウ ム (V₂O₃)、酸化レニウム (Re₂O₁) 等の金属酸化物;塩化第2鉄、臭化第2鉄 、ヨウ化第2鉄、塩化アルミニウム、臭化アルミニウム、ヨウ化アルミニウム、塩化ガリ ウム、臭化ガリウム、ヨウ化ガリウム、塩化インジウム、臭化インジウム、ヨウ化インジ ウム、5塩化アンチモン、5フッ化砒素、3フッ化ホウ素等の金属ハロゲン化物;等が挙 げられる。

[0076]

これらの中でも、前記電荷発生層形成材料として、 (a) イオン化ポテンシャルが 5. 7 e V より小さく、ホール輸送性すなわち電子供与性を有する有機化合物、及び (b) 前 記(a)の有機化合物と酸化還元反応による電荷移動錯体を形成しうる無機物質又は有機 物質からなる積層体又は混合層からなり、前記(a)成分と(b)成分との間で酸化還元 反応による電荷移動錯体が形成しているもののがさらに好ましい。

[0077]

また、一般に電子供与性を有する有機化合物が容易にラジカルカチオン状態となるには イオン化ポテンシャルが 5 . 7 e V より小さいことが望ましい。(a)成分の有機化合物の イオン化ポテンシャルが5.7eV以上であると、(b)成分の物質と酸化還元反応を起 こすことが難しくなり、結果的に本発明における電荷移動錯体の形成も困難になるからで 50

40

ある。

[0078]

なお、電荷発生層を構成する 2 種類の化合物が酸化還元反応により電荷移動錯体を形成しうるものであるか否かは、分光学的分析手段によって確認することができる。具体的には、 2 種類の化合物がそれぞれ単独では、 波長 8 0 0 ~ 2 0 0 0 n m の近赤外領域に吸収スペクトルのピークを示さないが、 2 種類の化合物の混合膜では、 波長 8 0 0 ~ 2 0 0 0 n m の近赤外領域に吸収スペクトルのピークがあり、 2 種類の化合物間での電子移動を明確に示唆する存在(もしくは証拠)として確認することができる。

[0079]

以上のようにして、図11に示すように、機能層27(発光層27b)及びバンク部2 10 8上に電荷発生層30が形成された基板10Eを得る。

[0080]

正孔注入/輸送層 (II) 形成工程 (S7) 及び発光層 (II) 形成工程 (S8)

次に、上記で得た基板10Eを用いて、前記パンク部の形成と同様にしてパンク部(II)31を形成し、前記正孔注入/輸送層(II)の形成と同様にして、電荷発生層30上に正孔注入/輸送層(II)32aを形成し(S7)、前記発光層(I)と同様にして、正孔注入/輸送層(II)32a上に発光層(II)32bを形成する(S8)。

以上のようにして、図12に示す基板10Fを得る。

[0081]

なお、本実施形態においては、前記正孔注入/輸送層形成材料、発光層形成材料、及び 20 電荷発生層形成材料を含むインク組成物は、次のような特性を有するのが好ましい。

[0082]

インク組成物の粘度は好ましくは 1 ~ 2 0 m P a · s であって、特に好ましくは 2 ~ 8 m P a · s である。インク組成物の粘度が 1 m P a · s 未満である場合、吐出量の制御が困難になるばかりでなく、固型分濃度が過少となり十分な膜を形成できないことがある。2 0 m P a · s を超える場合、ノズル孔からインク組成物を円滑に吐出させることができない恐れがあり、ノズル孔を大きくする等の装置の仕様を変更する必要が生じることがある。更に粘度が大きい場合、インク組成物中の固型分が析出し易く、ノズル孔の目詰まり頻度が高くなる。

[0083]

インク組成物の表面張力は好ましくは20~70mN/mであって、特に好ましくは25~45mN/mである。この範囲の表面張力にすることにより、インク吐出の際の飛行曲がりを抑えることができる。表面張力が20mN/m未満であると、インク組成物のノズル面上での濡れ性が増大するため、インク組成物を吐出する際、インク組成物がノズル孔の周囲に非対称に付着することがある。この場合、ノズル孔に付着した組成物と吐出しようとする付着物との相互間に引力が働くため、インク組成物は不均一な力により吐出されることになり目標位置に到達できない所謂飛行曲がりが生じ、もちろんその頻度も高くなる。また、70mN/mを超えるとノズル先端でのメニスカスの形状が安定しないためインク組成物の吐出量、吐出タイミングの制御が困難になる。

[0084]

インクジェット用ヘッドに設けられたインク組成物を吐出するノズル面を構成する材料に対する接触角は好ましくは30°~170°であり、特に好ましくは35°~65°である。インク組成物がこの範囲の接触角を持つことによって、インク組成物の飛行曲がりを制御することができ、精密なパターニングが可能となる。この接触角が30°未満である場合、インク組成物のノズル面を構成する材料に対する濡れ性が増大するため、表面張力の場合と同様、飛行曲がりが生じる。また、170°を超えると、インク組成物とノズル孔の相互作用が極小となり、ノズル先端でのメニスカスの形状が安定しないためインク組成物の吐出量、吐出タイミングの制御が困難になる。

[0085]

ここで飛行曲がりとは、インク組成物を前記ノズルから吐出させたとき、ドットの着弾 50

50

した位置が、目標位置に対して 5 0 μ m 以上のずれを生じることをいう。主にノズル孔の 濡れ性が不均一である場合やインク組成物の固型成分の付着による目詰まり等によって発 生する。

[0086]

また、インク組成物の固型分濃度は、組成物全体に対して 0.01~10.0wt%が 好ましく、0.1~5.0wt%が更に好ましい。固型分濃度が低すぎると必要な膜厚を 得るために吐出回数が多くなってしまい量産効率が悪くなってしまう。また高すぎても粘 度が高くなってしまい吐出性に影響を与える。

[0087]

上記固型分は室温での蒸気圧が0.005~50mmHgの少なくとも一つ以上の溶媒 10 に溶解または分散していることが望ましい。渇きにくい溶媒を用いることによりインク組 成物がノズル孔で乾燥し、増粘、凝集、固型分の付着が起こることを防ぐことができる。 しかし、蒸気圧が0.005mmHgを下回るような溶媒は、成膜過程で溶媒の除去が困 難であるため適さない。

[0088]

このような溶媒としては、 γ - ブチロラクトン、 N - メチルピロリドン(N M P)、 13 -ジメチル-2-イミダゾリジノン(D M I) 及びその誘導体等の非プロトン性環状 極性溶媒、またはカルピトールアセテート(CA)、ブチルカルピトールアセテート(B CA)等のグリコールエーテル系酢酸が挙げられる。CA、BCA等の溶媒は成膜性をあ げる点でも有効である。一方、メタノール (MeOH)、エタノール (EtOH)、プロ 20 ピルアルコール等の低級アルコールは表面張力、粘度の調整に有効であるが、揮発性が高 いため、20wt%以下であることが望ましい。

[0089]

陰極電極形成工程 (S9)

最後に、陰極電極(対向電極)形成工程 (S9) に移行する。

陰極電極形成工程(S9)では、発光層(II)32b及びパンク部(II)31の全 面に陰極電極33(対向電極)を、例えば蒸着法、スパッタ法、CVD法等によって形成 する。この陰極電極33は、本実施形態においては、例えば、カルシウム層とアルミニウ ム層とを積層して形成している。

[0090]

陰極電極材料としては、一般的には仕事関数の小さい金属、またそれらを含む合金、金 属酸化物等が用いられることが多い。具体的にはLi等のアルカリ金属、Mg、Ca等の アルカリ土類金属、Eu等の希土類金属等からなる金属単体、もしくは、これらの金属と Al、Ag、In等との合金等が挙げられる。また、陰電極と有機層との界面に金属ドー ピングされた有機層を用いる構成(特開平10-270171号公報、特開2001-1 0 2 1 7 5 号公報参照)では、陰電極は導電性材料であれば、その仕事関数等の性質は別 段、制限とはならない。

[0091]

同様に、特開平11-233262号公報及び特開2000-182774号公報に開 示した技術を使用して、陰極電極に接する有機層をアルカリ金属イオン、アルカリ土類金 40 属イオン及び希土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物により構 成する場合、該錯体化合物中に含有される金属イオンを真空中で金属に還元しうる金属、 例えば、Al、Zr、Ti、Si等の(熱還元性)金属、もしくはこれらの金属を含有す る合金を陰電極材料として使用することもできる。

これらの中でも、特に、配線電極として一般に広く使用されているアルミニウムが蒸着 の容易さ、光反射率の高さ、化学的安定性等の観点から好ましい。

[0092]

また、特開2002-332567号明細書に記載された手法を用いてITO成膜を有 機膜に損傷の無いスパッタリング法によって行う場合は、例えば、特開平10-2701 71号公報で記載されている金属ドーピングされた有機層を電子注入層に用いることで、

前述のITOやIZOのような透明導電材料を陰極材料に使用することも出来る。

このようにすることにより、陰極、陽極の両電極を透明として(有機膜も電荷発生層も同様に透明であるから)透明な発光素子を作ることも出来るし、上述の一般的な有機EL素子の場合とは逆に、陽極を金属として陰極を透明電極とすることで、基板側にではなく成膜面側から光をとりだす構造とすることもできる。

以上のようにして、陰極電極33を形成して、図13に示す基板10Gを得る。

100931

その後は、この陰極電極33の上部に図示を省略する封止部材により封止する封止処理 や配線処理等のその他の処理等を施すことにより、目的とする2層積層型の有機EL素子 を得ることができる。

なお本実施形態では、陽極側から成膜を開始しているが、陰極側から成膜を開始することもできる。

[0094]

得られる本実施形態の積層型有機EL素子は、従来の有機EL素子とは異なり、発光位置がとびとびに分離して複数存在しているのが大きな特徴であるから、各発光位置から光反射電極までの光学膜厚が全て1/4波長の略奇数倍(入×(2n-1)/4、ただし、n=1、2、3・・・)であるときに最も高効率の発光効率を得ることができる。

[0095]

また逆に、このような煩わしい厳密な膜厚調整の必要性から逃れるには、従来光反射電極であった陰極電極(この場合は陽極電極が透明電極となる)を黒色化して無反射電極と 20 するか、もしくは(発光層からみて)該陰極電極方向に存在する少なくとも一層を光吸収層として機能させることが出来れば、該光干渉効果に起因する問題に考慮する必要がなくなる。この場合には反射光を利用できない結果となるが、少なくとも前述の相殺現象という最悪の事態を回避することができる。また逆に、光反射電極が陽極電極である場合は、該陽極電極それ自身か、該陽極電極方向に存在する少なくとも一層が光吸収機能を有していればよい。また、どちらか一方の電極側が光乱反射面を有していれば(この場合はもう一方の電極が透明電極となる)原理的には該光干渉効果に起因する問題に考慮する必要がなくなる。

[0096]

本発明によれば、下記 (i) ~ (iv)に列挙した特徴を有する積層型有機EL素子を、高 30 い生産効率で製造することができる。

[0097]

(i) 従来の有機EL素子においては、「外部回路で測定される電子(数)/秒に対する、光子(数)/秒の比」である量子効率の上限は、理論上、1 (=100%) であったが、図1に示す有機EL素子においては理論上の限界はない。すなわち、電荷発生層によって仕切られた各発光ユニットの量子効率(各発光ユニットを(見かけ上)通過する電子(数)/秒と、各発光ユニットから放出される光子(数)/秒の比と定義される)の総和が積層型有機EL素子の量子効率となり、その値に上限はない。

[0098]

(II) 従来の有機EL素子の輝度は、電流密度にほぼ比例し、高輝度を得るためには高 40 い電流密度が必要であった。一方、素子寿命は電流密度に反比例するから、高輝度発光は素子寿命を短くする。これに対し、本発明により得られる積層型有機EL素子においては、例えば所望の電流密度においてn倍の輝度を得たい場合には、電極間に存在する同一の構成の発光ユニットをn個とすることで、電流密度を上昇させることなくn倍の輝度を実現できるので、素子寿命を長くすることができる。

[0099]

(iii) 従来型の有機EL素子は、駆動電圧の上昇は電力変換効率(W/W)の低下を招くだけであったが、図1に示す有機EL素子は、n個の発光ユニットを電極間に存在させると発光開始電圧も略n倍となり、量子効率もn倍となるので、理論上、電力変換効率(W/W)は変化しない。

20

30

[0100]

(iv) 従来型の有機EL素子では、発光ユニットが1個しかないため、発光ユニットを構成する膜中に存在するピンホール等の影響で陰極陽極間に短絡を生じた場合には、無発光素子となり使用できないが、図1に示す有機EL素子では、一つの発光ユニットに短絡を生じたとしても、他の発光ユニットに短絡が生じていないのであれば、発光素子として使用可能である。

[0101]

2) 表示装置

本発明の表示装置は、本発明の製造方法により得られた積層型有機EL素子を備えることを特徴とする。

本発明の表示装置において、有機EL素子の配置位置、大きさなどは特に制限されず、任意の位置に、所望の大きさのものを配置させることができる。

[0102]

本発明の表示装置としては、例えば、テレビ(大型、中型)、パソコン用ディスプレイ、PDA、デジタルカメラ、カーナビゲーション用ディスプレイ等が挙げられる。 また、本発明の積層型有機EL素子は、電子ペーパとしても好適である。

【図面の簡単な説明】

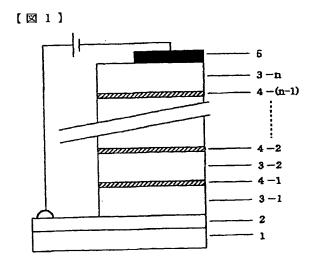
[0103]

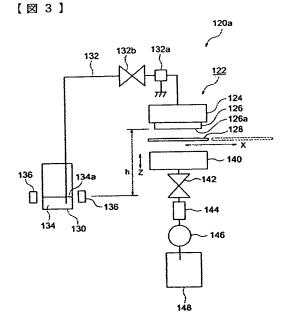
- 【図1】本発明により製造される積層型有機EL素子の層構成断面図である。
- 【図2】本発明により製造される2層積層型有機EL素子の層構成断面図である。
- 【図 3 】 実 施 の 形 態 に 係 る イ ン ク ジェッ ト 式 吐 出 装 置 の 概 略 図 で あ る 。
- 【図4】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造方法の工程図である。
- 【図 5 】 実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図6】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図7】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図8】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図9】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図10】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図11】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図12】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。
- 【図13】実施の形態に係る積層型有機EL素子の製造工程の断面図である。

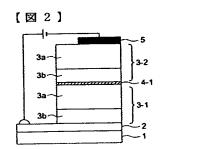
【符号の説明】

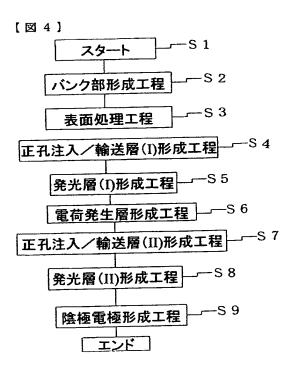
[0104]

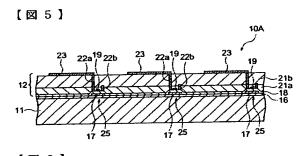
1, 11…透明基板、2…陽極電極、3-1, 3-2、3-n…発光ユニット、3 a…正孔注入/輸送層、3b…発光層、4-1、4-2、4-(n-1)…電荷発生層、5…陰極電極、10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G…基体、12…回路素子部、16…下地保護膜、17…半導体膜、18…ゲート絶縁膜、19…ゲート電極、21a…第1層間絶縁膜、21b…第2層間絶縁膜、22a, 22b…コンタクトホール、23…陽極電極、23a…陽極電極、23の電極面、24…電源線、25…薄膜トランジスタ、27…機能層、27a…正孔注入/輸送層(I)、27b…発光層(I)、28(4028a+28b)…バンク部、28a…無機物バンク層、28b…有機物バンク層、29…明口部、30…電荷発生層、31…バンク部(II)、32a…正孔注入/輸送層(I

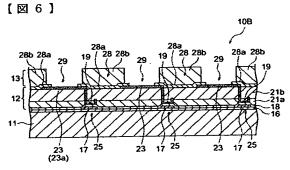


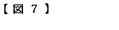


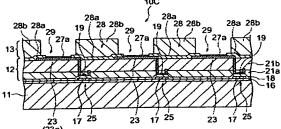




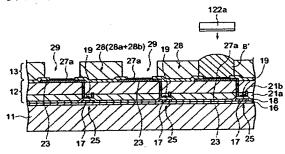




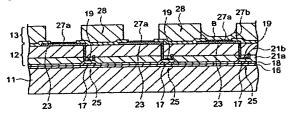




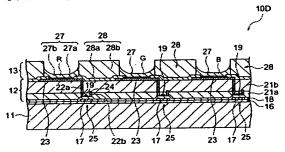
[図8]



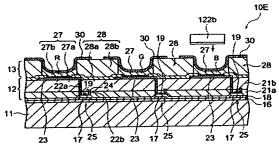
[図9]



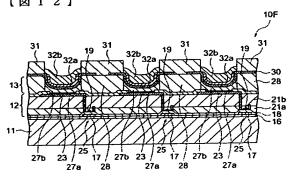
【図10】



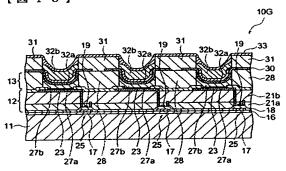
【図11】



【図12】



[図13]



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

FΙ

テーマコード(参考)

H 0 5 B 33/22

H 0 5 B 33/22 A H 0 5 B 33/22 B

Fターム(参考) 4D075 AC06 AC09 AC88 AC93 AE03 CA23 CB08 DA06 DB13 DC19 DC24 EA07 EC01 EC02 EC07